

ДВУМЕРНЫЙ ГАЗ ДЫРОК В ОДНОМЕРНОЙ СВЕРХРЕШЕТКЕ

З.Д.Квон, Б.Б.Кольцов, И.Г.Неизвестный, В.Н.Овсян

Обнаружена минищель в энергетическом спектре двумерных дырок в инверсионных каналах на высокоиндексных поверхностях кремния. Таким образом, впервые получено прямое экспериментальное свидетельство существования на таких поверхностях одномерной сверхрешетки.

В 1977 г. в работе [1] были обнаружены аномалии в переносе электронов в инверсионных каналах на высокоиндексных поверхностях кремния, обусловленные проявлением минищели (МШ) в спектре двумерных (2D) электронов. В ней было предположено, что это явление вызвано существованием на таких поверхностях одномерной сверхрешетки (СР) неизвестной природы. Независимо и одновременно в [2] было показано, что на поверхностях полупроводников с высокими индексами Миллера новый трансляционный период должен приводить к появлению СР, период которой зависит от ориентации поверхности ("ориентационная" СР). Однако в [1] содержались два факта, на первый взгляд, серьезно противоречившие предположению об одномерной СР: во-первых, сравнение периода идентичности с экспериментально измеренным дало резкое несогласие, во-вторых, в дырочных каналах при тех же условиях минищель обнаружена не была. По этой причине в [3] была предложена альтернативная модель междолинного расщепления, правильно предсказавшая положения МШ в $k_{||}$ -пространстве. В настоящее время все экспериментальные работы ограничиваются исследованием МШ в электронных каналах (см. обзор [4]), а все результаты (из последних см. [5]) интерпретируются в рамках модели междолинного расщепления, хотя в работе [6] было показано, что противоречия, полученные в [1], являются мнимыми и связаны с неправильным построением 2D зон Бриллюэна для электронов. Таким образом оказалось, что в электронных каналах и модель междолинного расщепления и одномерная СР приводят к одинаковым предсказаниям. Вследствие этого вопрос о существовании на высокоиндексных поверхностях кремния одномерной СР, способной приводить к экспериментально наблюдаемым эффектам, до сих пор оставался открытым и только обнаружение минищели в дырочных каналах могло бы его решить.

В данной работе впервые сообщается об обнаружении МШ в энергетическом спектре 2D дырок в инверсионных каналах на высокоиндексных поверхностях кремния, возникновение которой обусловлено именно одномерной СР.

Экспериментальные образцы представляли собой p-канальные МОП-транзисторы, изготовленные по обычной технологии на поверхностях кремния, отклоненных от поверхности (111) к поверхности (110) вокруг направления [011] соответственно на углы $\theta = 2,2^\circ$, $\theta = 2,5^\circ$ и $\theta = 3^\circ$. Толщина полевого диэлектрика 1100 – 1300 Å, подвижность дырок в максимуме при 4,2К 1000 – 1300 см²/В·сек. На рис. 1 приведены зависи-

мости проводимости инверсионного канала от приповерхностного избытка дырок Γ_p при 4,2К для угла $\theta = 2,2^\circ$ и для двух направлений тока — параллельно $[01\bar{1}]$ (G_k^{\parallel}) и перпендикулярно ему (G_k^{\perp}). Видно, что проводимость имеет анизотропный характер, причем $G_k^{\parallel} > G_k^{\perp}$ и разность между ними растет с увеличением Γ_p . Подобная анизотропия может быть в принципе обусловлена одномерными рассеивателями [7] и здесь обсуждаться не будет. Кроме того, на зависимости $G_k^{\perp}(\Gamma_p)$ достаточно ясно виден небольшой провал вблизи $\Gamma_p = 2 \cdot 10^{-12} \text{ см}^{-2}$; на зависимости же $G_k^{\parallel}(\Gamma_p)$ не наблюдается никаких особенностей. На рис. 2 (кривая 2) показана

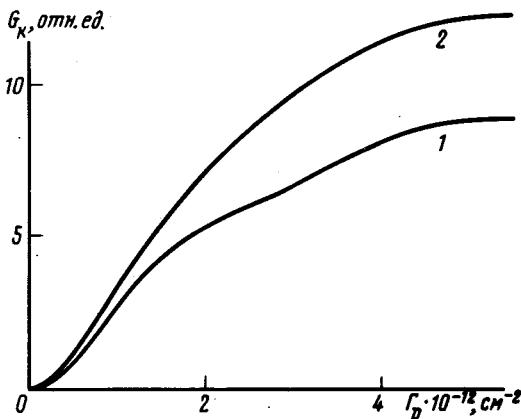


Рис. 1. Зависимость $G_k(\Gamma_p)$ для двух направлений тока дырок (1 — $G_k^{\perp}(\Gamma_p)$, 2 — $G_k^{\parallel}(\Gamma_p)$)

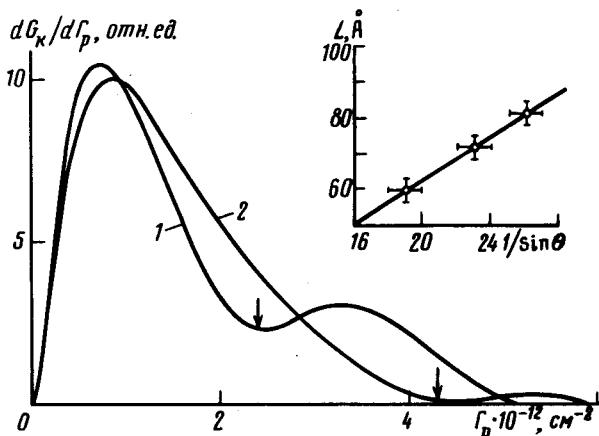


Рис. 2. Зависимость $dG_k^{\perp}/d\Gamma_p$ от Γ_p для двух углов наклона (1 — $\theta = 2,2^\circ$; 2 — $\theta = 3^\circ$; стрелками указаны положения особенностей). На вставке — зависимость периода СР от $(\sin\theta)^{-1}$ (точки — эксперимент, прямая — теоретическая зависимость $L_T = a / \sqrt{3 \sin\theta}$)

зависимость $dG_k^{\perp}/d\Gamma_p$ от Γ_p , положение аномалии на которой может быть определено значительно точнее. Если связать данную особенность с наличием МШ, появляющейся в результате воздействия одномерной СР [2], то ее положение в k_{\parallel} -пространстве должно однозначно определяться периодом идентичности L_T (который, собственно, и является периодом СР) в направлении "скока" поверхности. В нашем случае $L_T = a / \sqrt{3 \sin\theta}$, где $a = 5,43 \text{ \AA}$ — постоянная решетки кремния. Известно, что для поверхности (111) условие заполнения только основной подзоны квантования строго выполняется в дырочных каналах при 4,2К до концентраций $5,5 \cdot 10^{12} \text{ см}^{-2}$ [8]. С учетом этого для граничных значений k_F^{Δ} и Γ_p^{Δ} , соответствующих началу "аномалий" на зависимостях G_k^{\perp} или $dG_k^{\perp}/d\Gamma_p$ от Γ_p , получим $k_F^{\Delta} = \pi/L = (\pi\sqrt{3}/a)\sin\theta$ и $\Gamma_p^{\Delta} = (k_F^{\Delta})^2/2\pi = \pi/2L^2$, где L — период одномерной СР. Пользуясь этими соотноше-

ниями, можно определить L по экспериментальному значению $\Gamma_{p_0}^\Delta$ и сравнить его с периодом идентичности L_T . Для $\theta = 2,2^\circ$ $L_T = 82\text{ \AA}$, действительно, практически совпадает с экспериментальным значением периода СР $L_9 = 80 + 85\text{ \AA}$. Однако наиболее ярким проявлением СР является сдвиг аномалии с изменением угла θ по закону $\Gamma_p^\Delta \sim \sin^2 \theta$. Этот сдвиг при переходе к углу 3° иллюстрируется кривой 2 на рис. 2, а на вставке к этому рисунку приведены полученные из эксперимента периоды СР для всех трех исследованных углов. Как видно, измеренные значения хорошо легли на прямую $L_T = a/\sqrt{3}\sin\theta$. Такое поведение обнаруженной аномалии в проводимости дырок позволяет уже определенно говорить, что она обусловлена МШ, вызванной воздействием одномерной СР, период которой совпадает с периодом идентичности вицинальной поверхности кремния.

Форма особенности позволяет (правда, с невысокой точностью из-за сильного размытия, вызванного рассеянием дырок) оценить величину Δ обнаруженной МШ. Оценка дает $3 \text{ мэВ} < \Delta < 6 \text{ мэВ}$, и, таким образом, Δ сравнима с величиной МШ в спектре двумерных электронов при тех же величинах приповерхностных избыточных носителей заряда. Отсюда же вытекает, что влияние одномерной СР должно обязательно учитываться и при анализе данных о МШ в спектре 2D электронов.

В заключение следует отметить, что одномерная СР может быть обусловлена не только появлением новой трансляционной симметрии на высокониндексной поверхности кремния, но и одномерной периодической структурой обнаруженной недавно в [9]. Выяснение относительной роли этих двух факторов требует дальнейших экспериментов.

Институт физики полупроводников
Академии наук СССР
Сибирское отделение

Поступила в редакцию
15 апреля 1981 г.

Литература

- [1] T.Cole, A.Laknani, P.J.Stiles. Phys. Rev. Lett. **38**, 722, 1977.
- [2] В.А.Петров, Сб. тезисов докладов VI Всесоюзного совещания по физике поверхности полупроводников. Киев, ч. 2, стр. 80, 1977; ФТП, 12, 380, 1978.
- [3] L.J.Sham, S.J.Allen, A.Kamgar, D.C.Tsui. Phys. Rev. Lett., **40**, 472 1978.
- [4] В.А.Волков, В.А.Петров, В.Б.Сандомирский. УФН, **131**, 423, 1980.
- [5] A.Kamgar, M.Sturge, D.C.Tsui. Phys. Rev., B22, 841, 1980.
- [6] В.А.Волков, В.Б.Сандомирский. Письма в ЖЭТФ, **27**, 688, 1978.
- [7] З.Д.Квон, И.Г.Неизвестный, В.Н.Овсяк, Г.А.Ягунова. Письма в ЖЭТФ, **32**, 370. 1980.
- [8] A.Laknani, P.J.Stiles, J.C.Cheng. Phys. Rev. Lett., **32**, 1003, 1974.
- [9] Б.З.Ольшанецкий, А.В.Ржанов. Письма в ЖЭТФ, **32**, 337, 1980.